



Espacenet Patent search

コンタクト 国の変更

Espacenetについて その他のEPOのオンラインサービス

検索 Result list マイパテントリスト(0) クエリの履歴 設定 Help

検索更新 → Results → US5334277(A) → EP0482648(B1)

- EP0482648 (B1)
- 書誌事項**
- 詳細
- 請求項
- モザイク
- 原文献
- Cited documents
- Citing documents
- INPADOCのリーガルステータス
- INPADOC Patent Family

クイックヘルプ

- What is meant by high quality text as facsimile?
- 「さらに...として公表した」というリストの中のEP出版番号の後に書いてあるA1,A2,A3およびBの意味は何ですか。
- What happens if I click on "In my patents list"?
- What happens if I click on the "Register" button?
- なぜある文献へアクセスするいくつかのタブは非活性化されましたか。
- How can I bookmark this page?
- なぜ「さらに...として公表した」という標題の下の文献のリストは時々現われる。また、これらの文献は何ですか。
- なぜ、時々対応する文献の抄録文を見つめますか。
- What happens if I click on the red "patent translate" button?
- What is Global Dossier?

### 書誌事項: EP0482648 (B1) — 2002-01-30

★マイパテントリストへ Register Report data error 印刷

### Method of vapour growing a semiconductor crystal

Page bookmark EP0482648 (B1) - Method of vapour growing a semiconductor crystal

発明者: NAKAMURA SHUJI [JP] ±

出願人: NICHIA KAGAKU KOGYO KK [JP] ±

分類: —国際: C30B25/02; C30B25/14; (IPC1-7): C23C16/44; C30B25/14; H01L21/205  
- cooperative: C30B25/02 (EP); C30B25/14 (EP); C30B29/40 (EP); C30B29/403 (EP); C30B29/406 (EP); C30B29/42 (EP)

出願番号: EP19910118176 19911024 Global Dossier

優先権主張番号: JP19910074822 19910313; JP19900288655 19901025

他の公開: EP0482648 (A1); DE69132911 (T2); US5334277 (A)

### 要約 EP0482648 (A1)

Translate this text Select language patenttranslate powered by EPO and Google

A method of growing in vapor phase a semiconductor crystal layer supplies a reaction gas to a portion above the surface of a heated substrate (1) so as to be parallel or obliquely to the substrate (1), and uses a transparent blow tube (3) widened toward its blow port like a funnel to blow a pressing gas, which is inert with respect to the reaction gas, toward the substrate (1), thereby bringing the reaction gas into contact with the surface of the substrate (1).

